

ТРАНЗИСТОР 2Т505В

Дополнение к техническим условиям

АО.339.174 Д1

выписка

Настоящее дополнение к техническим условиям аА0.339.174 ТУ устанавливает дополнительные требования к транзисторам 2Т505В, предназначенным для работы в микрорежиме высоковольтных стабилизаторов напряжения в качестве регулирующих элементов и другой аппаратуре специального назначения для предприятий, давших согласие на их поставку.

Дополнение применяют в комплексе с аА0.339.174 ТУ.

Пункты (подразделы, разделы, приложения) настоящего дополнения заменяют пункты (подразделы, разделы, приложения) технических условий аА0.339.174 ТУ, имеющие те же номера.

Пункты 1.1, 2.3.5.1, 2.3.5.3, 2.6.4, 5.3.1.2, 5.3.1.5, 8.2, приложение 2 аА0.339.174 ТУ не применять.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.5. Условное обозначение транзисторов при заказе и в конструкторской документации другой продукции :

Транзистор 2Т505В аА0.339.174 ТУ/Д1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.3. Требования к электрическим параметрам и режимам эксплуатации

2.3.1. Электрические параметры транзисторов при приемке и поставке соответствуют нормам, установленным в табл.2.

Таблица 2

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквен- ное обозначе- ние	Норма		Темпе- ратура, °C
		не менее	не более	
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{КБ} = 450 \text{ В}$)	$J_{КБ0}$		5 10	25 85
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА ($U_{КЭ} = 400 \text{ В}, R_{БЭ} \leq 3 \text{ кОм}$)	$J_{КЭР}$		10	25
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{ЭБ} = 5 \text{ В}$)	$J_{ЭБ0}$		5	25
Статический коэффициент пере- дачи тока ($U_{КБ} = 10 \text{ В}, J_{Э} = 0,1 \text{ мА}$)	$h_{21Э}$	15 12 10		25 85 -60
Напряжение насыщения коллек- тор-эмиттер, В ($J_{К} = 0,1 \text{ мА}, J_{Б} = 10 \text{ мкА}$)	$U_{КЭнас}$		1	25

2.3.2. Электрические параметры транзисторов, изменяющиеся в течение минимальной наработки, в пределах времени, равного минимальному сроку сохраняемости, и нормы на них установлены в табл.3. Остальные параметры соответствуют нормам, установленным в табл.2.

Таблица 3

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквен- ное обозначе- ние	Норма		Темпе- ратура, °C
		не менее	не более	
Обратный ток коллекто- ра, мкА ($U_{КБ} = 450 \text{ В}$)	$J_{КБ0}$		8	25
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ} = 10 \text{ В}$, $J_э = 0,1 \text{ мА}$)	$h_{21э}$	12		25

2.3.4. Электрические параметры транзисторов в течение минимального срока сохраняемости соответствуют нормам, установленным в табл.2.

2.3.5. Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации транзисторов в диапазоне рабочих температур установлены в табл.5 и п. 2.3.5.2.

Таблица 5

Наименование параметра, режима, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма	Примечание
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В, ($R_{БЭ} \leq 3 \text{ ком}$)	$U_{кэmax}$	400	I,5
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{кбmax}$	450	I,5
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{эбmax}$	5	I
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{кmax}$	20	I,2
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при температуре корпуса от минус 60 до 25 °С (с теплоотводом), Вт	$P_{кmax}$	I	3
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при температуре окружающей среды от минус 60 до 25 °С (без теплоотвода), Вт	$P_{кmax}$	0,3	4

- Примечания:
1. В диапазоне температур корпуса транзистора от минус 60 до 85 °С.
 2. При условии непревышения мощности.
 3. В диапазоне температур корпуса от 25 до 85 °С мощность линейно снижается на 8 мВт на градус.
 4. В диапазоне температур окружающей среды от 25 до 85 °С мощность линейно снижается на 3,33 мВт на градус.
 5. Максимально допустимая скорость нарастания обратного напряжения

$$\left(\frac{dU_k}{dt} \right) \leq 150 \text{ В/мкс}$$

2.3.5.2. Максимально допустимая температура перехода
150 °С

2.4. Требование по стойкости к внешним воздействующим факторам

2.4.1. Механические, климатические и биологические воздействия по ГОСТ В 28146, в том числе :

повышенная рабочая температура среды
(корпуса) 85 °С

изменения температуры среды от
минус 60 до 125 °С

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.2. Основное назначение транзистора - работа в микрорежиме высоковольтных стабилизаторов напряжения в качестве регулирующих элементов и другой аппаратуре специального назначения.